

# Pressemitteilung

2021-04-28

## Integration von Lasern in elektro-optische Silizium-Technologien

### Prof. Gadi Eisenstein erhält Wolfgang Mehr Fellowship Award

**Frankfurt (Oder).** Der Preisträger des Wolfgang Mehr Fellowship Awards 2020 heißt Prof. Gadi Eisenstein vom Israel Institute of Technology (Technion). Die Verleihung fand bedingt durch die Pandemie erst am heutigen Tag in virtueller Form statt. Prof Eisenstein erhält den vom Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik (IHP) initiierten Preis für seine Forschung im Bereich der Halbleiterphotonik, insbesondere von Lasern und Verstärkern, die auf Quantenpunkten basieren.

Durch die Auszeichnung hat Prof. Eisenstein die Möglichkeit in enger Kooperation mit den Kollegen direkt am IHP zu forschen. „Wir freuen uns mit Gadi Eisenstein einen renomierten Experten auf dem Gebiet der integrierten Photonik als Kooperationspartner gewonnen zu haben und erhoffen uns neue Impulse für zukünftige Entwicklungen“ sagt Prof. Zimmermann, Gruppenleiter „Si-Photonik“ am IHP, zur Verleihung des Awards. Aufgrund der Corona-Pandemie ist es Prof. Eisenstein jedoch derzeit nicht möglich, seine Forschungstätigkeit am IHP vor Ort auszuüben. Dennoch plant er, in der Zukunft das Institut mehrmals zu besuchen, um gemeinsam mit den Wissenschaftlern\*innen des IHP an der Integration von Bauelementen in Silizium-Plattformen zu arbeiten. „Ich glaube, dass der Preis es mir ermöglichen wird, den Umfang meiner Forschung und meiner deutschen Kooperationen zu erweitern“, so der Preisträger.

Prof. Gadi Eisenstein leitet den Diane und Mark Seiden Lehrstuhl für Optoelektronik am Technion in Haifa, Israel, und das Russell Berrie Nanotechnologie Institut (RBNI). Nach seiner Promotion 1980 an der Universität Minnesota, USA, hat er 10 Jahre im AT&T Bell Laboratorium, Crawford Holl, in der Abteilung für Photonische Schaltungen gearbeitet. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen der optischen Verstärker und der dynamischen Eigenschaften von Laserdioden. Zu seinen Forschungsthemen gehört auch die Ausbreitung von Licht in nichtlinearen Fasern sowie die Miniaturisierung von Atomuhren. Er ist Mitglied des renommierten venezianischen Forschungs- und Kulturinstituts (Akademie Instituto Veneto Di Scienze, Lettere Ed Arti). 2014 hat Prof. Gadi Eisenstein den IEEE William Streifer Preis für wissenschaftliche Errungenschaften erhalten. Außerdem wurde er im Jahr 2007 und 2017 von der deutschen Stiftung mit dem Alexander von Humboldt-Preis ausgezeichnet.

Der Fellowship Award wird seit 2016 verliehen und trägt den Namen des ehemaligen wissenschaftlichen Direktors des IHP Prof. Dr. Wolfgang Mehr, der 2015 verstorben ist. Prof. Mehr hat das Institut von 2002 bis 2014 mit einer zukunftsfähigen Strategie geleitet und hat es zu einer international anerkannten, exzellenten Forschungseinrichtung geführt. Gerade durch diese lösungsorientierte Zielstrebigkeit sind die Preisträger von „Wolfgang Mehr“ Fellowship Award ausgezeichnet.



Leibniz Institute  
for high  
performance  
microelectronics



# Pressemitteilung



Leibniz Institute  
for high  
performance  
microelectronics



Prof. Gadi Eisenstein vom Israel Institute of  
Technology (Technion)

## Ansprechpartner

Katja Werner

Public Relations

IHP GmbH - Innovations for High Performance Microelectronics/

Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik

Im Technologiepark 25

15236 Frankfurt (Oder)

Fon: +49 (335) 5625 206

E-Mail: [werner@ihp-microelectronics.com](mailto:werner@ihp-microelectronics.com)

Website: [www.ihp-microelectronics.com](http://www.ihp-microelectronics.com)

## Über das IHP:

Das IHP ist ein Institut der Leibniz-Gemeinschaft und betreibt Forschung und Entwicklung zu siliziumbasierten Systemen, Höchstfrequenz-Schaltungen und -Technologien einschließlich neuer Materialien. Es erarbeitet innovative Lösungen für Anwendungsbereiche wie die drahtlose und Breitbandkommunikation, Sicherheit, Medizintechnik, Industrie 4.0, Mobilität und Raumfahrt. Das IHP beschäftigt ca. 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es verfügt über eine Pilotlinie für technologische Entwicklungen und die Präparation von Hochgeschwindigkeits-Schaltkreisen mit 0,13/0,25  $\mu\text{m}$ -SiGe-BiCMOS-Technologien, die sich in einem 1500 m<sup>2</sup> großen Reinraum DIN EN ISO 14644-1 3 befindet.

[www.ihp-microelectronics.com](http://www.ihp-microelectronics.com)

